

# THE LASER BEAM MACHINING METHOD

Publication number: JP2004001076

Publication date: 2004-01-08

Inventor: FUKUMITSU KENJI; FUKUYO FUMITSUGU;  
UCHIYAMA NAOKI

Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

Classification:

- international: B28D5/00; B23K26/00; B23K26/40; H01L21/301;  
H01L21/304; B23K101/36; B28D5/00; B23K26/00;  
H01L21/02; (IPC1-7): B23K26/00; B28D5/00;  
H01L21/301; H01L21/304; B23K101/36

- european: B23K26/40B6

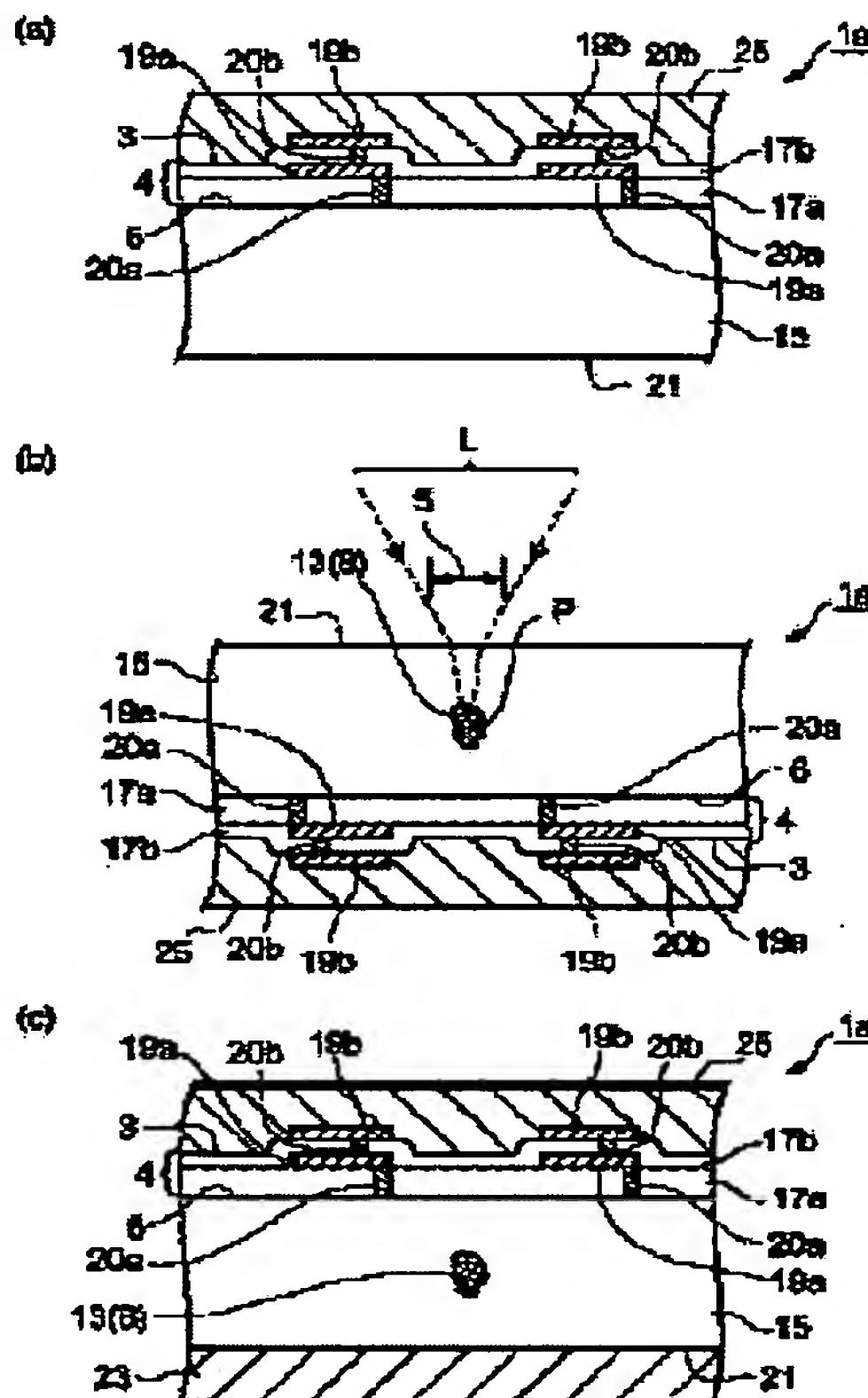
Application number: JP20030067276 20030312

Priority number(s): JP20030067276 20030312; JP20020067348 20020312;  
JP20020067372 20020312

[Report a data error here](#)

## Abstract of JP2004001076

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a laser beam machining method by which a processing object can be cut with high precision even though the processing object has various laminated structures.



Data supplied from the [esp@cenet](mailto:esp@cenet) database - Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-1076  
(P2004-1076A)

(43) 公開日 平成16年1月8日(2004. 1. 8)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>  
**B23K 26/00**  
**B28D 5/00**  
**H01L 21/301**  
**H01L 21/304**  
// **B23K 101:36**

F 1  
B23K 26/00 320E  
B28D 5/00 Z  
H01L 21/304 631  
H01L 21/78 B  
H01L 21/78 Q

テーマコード(参考)  
3C069  
4E068

審査請求 未請求 請求項の数 9 O.L. (全 28 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-67276 (P2003-67276)  
(22) 出願日 平成15年3月12日 (2003. 3. 12)  
(31) 優先権主張番号 特願2002-67348 (P2002-67348)  
(32) 優先日 平成14年3月12日 (2002. 3. 12)  
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)  
(31) 優先権主張番号 特願2002-67372 (P2002-67372)  
(32) 優先日 平成14年3月12日 (2002. 3. 12)  
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000236436  
浜松ホトニクス株式会社  
静岡県浜松市市野町 1126 番地の 1  
(74) 代理人 100088155  
弁理士 長谷川 芳樹  
(74) 代理人 100089978  
弁理士 堀田 辰也  
(74) 代理人 100092657  
弁理士 寺崎 史朗  
福満 蓮志  
静岡県浜松市市野町 1126 番地の 1 浜  
松ホトニクス株式会社内  
(72) 発明者 福世 文嗣  
静岡県浜松市市野町 1126 番地の 1 浜  
松ホトニクス株式会社内

最終頁に続く

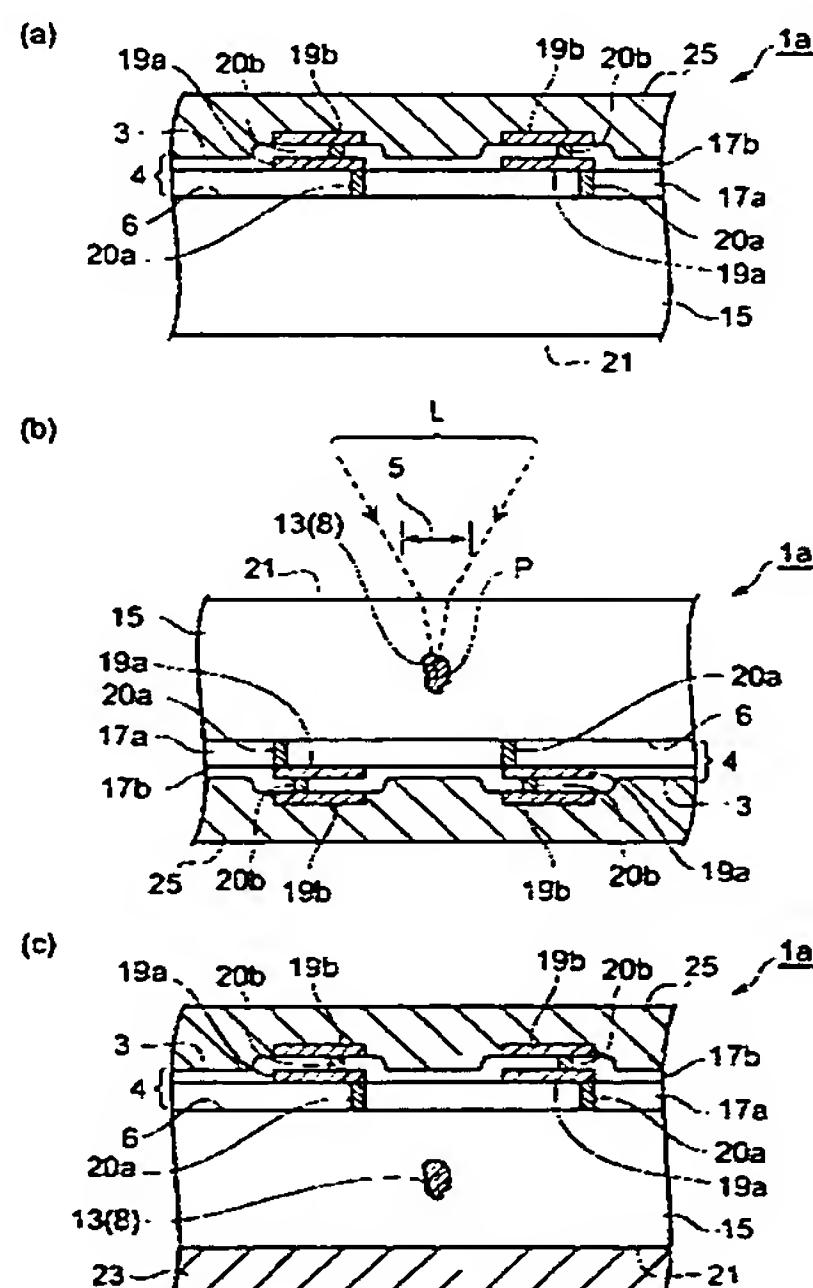
(54) 【発明の名称】 レーザ加工方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても加工対象物を高精度に切断することのできるレーザ加工方法を提供する。

【解決手段】 ウェハ 1a の表面 3 に保護テープ 25 を装着し、ウェハ 1a の裏面 21 をレーザ光入射面として基板 15 の内部に集光点 P を合わせてレーザ光 L を照射することにより多光子吸収による溶融処理領域 13 を形成し、この溶融処理領域 13 によって、ウェハ 1a の切断予定ライン 5 に沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域 8 を形成し、ウェハ 1a の裏面 21 にエキスパンドテープ 23 を装着し、切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1a が切断されることにより生じた複数のチップ状部分を、エキスパンドテープ 23 を伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とする。

【選択図】 図20



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記切断起点領域を起点として前記加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備える、レーザ加工方法。

10

**【請求項 2】**

基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記加工対象物に外力を印加することにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

20

**【請求項 3】**

基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の前記裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断するとともに前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

30

**【請求項 4】**

半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより溶融処理領域を形成し、この溶融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記切断起点領域を起点として前記加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備える、レーザ加工方法。

40

**【請求項 5】**

半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより溶融処理領域を形成し、この溶融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記加工対象物に外力を印加することにより前

50

記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切斷し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

**【請求項 6】**

半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切斷するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の前記裏面をレーザ光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより溶融処理領域を形成し、この溶融処理領域によって、前記加工対象物の切斷予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切斷起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記切斷起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切斷するとともに前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。10

**【請求項 7】**

前記加工対象物に前記切斷起点領域を形成する前に、前記加工対象物の前記基板が薄くなるように前記加工対象物の前記裏面を研削する、請求項 1～6 のいずれか一項に記載のレーザ加工方法。

**【請求項 8】**

前記伸張性のフィルムを前記加工対象物に装着した後、前記保護フィルムを除去する、請求項 1～7 のいずれか一項に記載のレーザ加工方法。20

**【請求項 9】**

前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分に分離した後、前記保護フィルムを除去する、請求項 1～7 のいずれか一項に記載のレーザ加工方法。

**【発明の詳細な説明】**

**【0001】**

**【従来の技術】**

近年、半導体デバイス用として  $\text{Al}_2\text{O}_3$  基板上に GaN 等の半導体動作層を結晶成長させたものや、液晶表示装置用としてガラス基板上に他のガラス基板を貼り合わせたもの等、種々の積層構造を有する加工対象物を高精度に切斷する技術が求められている。30

**【0002】**

従来、これらの積層構造を有する加工対象物の切斷には、ブレードダイシング法やダイヤモンドスクライプ法が使用されるのが一般的である。

**【0003】**

ブレードダイシング法とは、ダイヤモンドブレード等により加工対象物を切削して切斷する方法である。一方、ダイヤモンドスクライプ法とは、ダイヤモンドポイントツールにより加工対象物の表面にスクライブラインを設け、このスクライブラインに沿うよう加工対象物の裏面にナイフエッジを押し当てて、加工対象物を割って切斷する方法である。

**【0004】**

**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、ブレードダイシング法にあっては、例えば、加工対象物が上述した液晶表示装置用のものである場合、ガラス基板と他のガラス基板との間に隙間が設けられているため、この隙間に削り屑や潤滑洗浄水が入り込んでしまうおそれがある。

**【0005】**

また、ダイヤモンドスクライプ法にあっては、加工対象物が  $\text{Al}_2\text{O}_3$  基板等の硬度の高い基板を有している場合や、或いは、加工対象物がガラス基板同士を貼り合わせたものである場合等に、加工対象物の表面だけでなく裏面にもスクライブラインを設けなければならず、この表面と裏面とに設けられたスクライブラインの位置ずれによって切斷不良が生じるおそれがある。

**【0006】**

10

20

30

40

50

そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、上述したような問題を解決し、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても加工対象物を高精度に切断することのできるレーザ加工方法を提供することを目的とする。

#### 【0007】

##### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、切断起点領域を起点として加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離することを特徴とする。10

#### 【0008】

また、本発明に係るレーザ加工方法は、半導体基板と、半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより溶融処理領域を形成し、この溶融処理領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、切断起点領域を起点として加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離することを特徴とする。20

#### 【0009】

これらのレーザ加工方法によれば、加工対象物の表面に保護フィルムを装着することによって、加工対象物を裏面を上にして台上に載置することができるので、加工対象物の裏面から（半導体）基板の内部にレーザ光を好適に照射することができる。そして、多光子吸収という現象により形成される改質領域（溶融処理領域）でもって、加工対象物を切断すべき所望の切断予定ラインに沿った切断起点領域を基板の内部に形成し、この切断起点領域を起点として加工対象物を切断することができる。そして、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着してこれを伸張させることにより、切断された加工対象物の複数の部分を容易に分離することができる。すなわち、本レーザ加工方法によれば、加工対象物の表面にある積層部にレーザ光を直接照射せずに切断起点領域を形成できるとともに、切断起点領域を起点として基板を比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断された加工対象物を容易に分離することができる。従って、このレーザ加工方法によれば、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。30

#### 【0010】

ここで、基板上の積層部とは、基板の表面に堆積されたもの、基板の表面に貼り合わされたもの、或いは基板の表面に取り付けられたもの等をいい、基板に対し異種材料であるか同種材料であるかは問わない。そして、積層部には、基板に密着して設けられるものや、基板と間隙を取って設けられるもの等がある。例としては、基板上に結晶成長により形成された半導体動作層や、ガラス基板上に貼り合わされた他のガラス基板等があり、積層部は異種材料を複数層形成したものも含む。また、基板の内部とは、積層部が設けられている基板の表面上をも含む意味である。さらに、集光点とは、レーザ光が集光した箇所のことである。そして、切断起点領域は、改質領域が連続的に形成されることで形成される場合もあるし、改質領域が断続的に形成されることで形成される場合もある。40

#### 【0011】

また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域に50

よって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、加工対象物に外力を印加することにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断し、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

#### 【0012】

また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、加工対象物に外力を印加することにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断し、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。10

#### 【0013】

これらのレーザ加工方法によれば、上述したレーザ加工方法と同様の理由により、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。また、加工対象物を複数の部分に切断する際に加工対象物に外力を印加することによって、切断起点領域を起点として加工対象物を容易に切断することができる。20

#### 【0014】

また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、伸張性のフィルムを伸張させることにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断するとともに加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

#### 【0015】

また、本発明に係るレーザ加工方法は、半導体基板と、半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより溶融処理領域を形成し、この溶融処理領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、伸張性のフィルムを伸張させることにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断するとともに加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。30

#### 【0016】

これらのレーザ加工方法によれば、上述したレーザ加工方法と同様の理由により、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。また、伸張性のフィルムを伸張させることにより、加工対象物の切断起点領域に引張応力が印加されるので、加工対象物を切断する工程と複数の部分を分離する工程と同時にを行うことができ、製造工程を削減することができる。40

#### 【0017】

また、上述した本発明に係るレーザ加工方法においては、加工対象物に切断起点領域を形成する前に、加工対象物の基板が薄くなるように加工対象物の裏面を研削することが好ましい。これによって、切断起点領域を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせずに加工対象物を精度良く切断することができる。

#### 【0018】

50

また、上述した本発明に係るレーザ加工方法においては、伸張性のフィルムを加工対象物に装着した後、保護フィルムを除去することが好ましい。これによって、切断起点領域が形成された加工対象物を離散させることなく保持することができる。或いは、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離した後、保護フィルムを除去することが好ましい。これによって、加工対象物を切断してから複数の部分を取り出すまでの間、該複数の部分を保護することができる。

#### 【0019】

##### 【発明の実施の形態】

以下、図面と共に本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。本実施形態に係るレーザ加工方法では、加工対象物の内部に多光子吸収による改質領域を形成する。そこで、  
10 このレーザ加工方法、特に多光子吸収について最初に説明する。

#### 【0020】

材料の吸収のバンドギャップ  $E_G$  よりも光子のエネルギー  $h\nu$  が小さいと光学的に透明となる。よって、材料に吸収が生じる条件は  $h\nu > E_G$  である。しかし、光学的に透明でも、レーザ光の強度を非常に大きくすると  $n h\nu > E_G$  の条件 ( $n = 2, 3, 4, \dots$ ) で材料に吸収が生じる。この現象を多光子吸収という。パルス波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点のピークパワー密度 ( $\text{W}/\text{cm}^2$ ) で決まり、例えばピークパワー密度が  $1 \times 10^8$  ( $\text{W}/\text{cm}^2$ ) 以上の条件で多光子吸収が生じる。ピークパワー密度は、  
20 (集光点におけるレーザ光の 1 パルス当たりのエネルギー) ÷ (レーザ光のビームスポット断面積 × パルス幅) により求められる。また、連続波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点の電界強度 ( $\text{W}/\text{cm}^2$ ) で決まる。

#### 【0021】

このような多光子吸収を利用する本実施形態に係るレーザ加工の原理について、図 1～図 6 を参照して説明する。図 1 はレーザ加工中の加工対象物 1 の平面図であり、図 2 は図 1 に示す加工対象物 1 の I-I'I'I' 線に沿った断面図であり、図 3 はレーザ加工後の加工対象物 1 の平面図であり、図 4 は図 3 に示す加工対象物 1 の IV-IV' 線に沿った断面図であり、図 5 は図 3 に示す加工対象物 1 の V-V' 線に沿った断面図であり、図 6 は切断された加工対象物 1 の平面図である。

#### 【0022】

図 1 及び図 2 に示すように、加工対象物 1 の面 10 には、加工対象物 1 を切断すべき所望の切断予定ライン 5 がある。切断予定ライン 5 は直線状に延びた仮想線である（加工対象物 1 に実際に線を引いて切断予定ライン 5 としてもよい）。本実施形態に係るレーザ加工は、多光子吸収が生じる条件で加工対象物 1 の内部に集光点 P を合わせてレーザ光 L を加工対象物 1 に照射して改質領域 7 を形成する。なお、集光点とはレーザ光 L が集光した箇所のことである。また、加工対象物 1 の面 10 はレーザ光が入射されるレーザ光入射面となっており、該面 10 においてレーザ光 L が散乱することを防ぐため、平坦かつ滑面であることが好ましい。

#### 【0023】

レーザ光 L を切断予定ライン 5 に沿って（すなわち矢印 A 方向に沿って）相対的に移動させることにより、集光点 P を切断予定ライン 5 に沿って移動させる。これにより、図 3～図 5 に示すように改質領域 7 が切断予定ライン 5 に沿って加工対象物 1 の内部にのみ形成され、この改質領域 7 でもって切断起点領域 8 が形成される。本実施形態に係るレーザ加工方法は、加工対象物 1 がレーザ光 L を吸収することにより加工対象物 1 を発熱させて改質領域 7 を形成するのではない。加工対象物 1 にレーザ光 L を透過させ加工対象物 1 の内部に多光子吸収を発生させて改質領域 7 を形成している。よって、加工対象物 1 の面 10 ではレーザ光 L がほとんど吸収されないので、加工対象物 1 の面 10 が溶融することはない。

#### 【0024】

加工対象物 1 の切断において、切断する箇所に起点があると加工対象物 1 はその起点から割れるので、図 6 に示すように比較的小さな力で加工対象物 1 を切断することができる。

10

20

30

40

50

よって、加工対象物 1 の面 10 に不必要な割れを発生させることなく加工対象物 1 の切断が可能となる。

## 【0025】

さて、本実施形態において多光子吸収により形成される改質領域としては、次の(1)～(3)がある。

## 【0026】

(1) 改質領域が 1 つ又は複数のクラックを含むクラック領域の場合

基板(例えばサファイア、ガラス、または  $\text{LiTaO}_3$  からなる圧電材料)の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が  $1 \times 10^8$  ( $\text{W}/\text{cm}^2$ ) 以上で且つパルス幅が  $1 \mu\text{s}$  以下の条件でレーザ光を照射する。このパルス幅の大きさは、多光子吸収を生じさせつつ基板の面に余計なダメージを与える前に、基板の内部にのみクラック領域を形成できる条件である。これにより、基板の内部には多光子吸収による光学的損傷という現象が発生する。この光学的損傷により基板の内部に熱ひずみが誘起され、これにより基板の内部にクラック領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば  $1 \times 10^{12}$  ( $\text{W}/\text{cm}^2$ ) である。パルス幅は例えば  $1\text{n}\text{s} \sim 200\text{n}\text{s}$  が好ましい。

10

## 【0027】

本発明者は、電界強度とクラックの大きさとの関係を実験により求めた。実験条件は次ぎの通りである。

(A) 基板：パイレックス(登録商標)ガラス(厚さ  $700\mu\text{m}$ )

20

(B) レーザ

光源：半導体レーザ励起 Nd : YAG レーザ

波長： $1064\text{nm}$

レーザ光スポット断面積： $3.14 \times 10^{-8}\text{ cm}^2$

発振形態：Qスイッチパルス

繰り返し周波数： $100\text{kHz}$

パルス幅： $30\text{ns}$

出力：出力  $< 1\text{mJ}/\text{パルス}$

レーザ光品質： $\text{TEM}_{00}$

偏光特性：直線偏光

30

(C) 集光用レンズ

レーザ光波長に対する透過率：60パーセント

(D) 基板が載置される載置台の移動速度： $100\text{mm}/\text{秒}$

## 【0028】

なお、レーザ光品質が  $\text{TEM}_{00}$  とは、集光性が高くレーザ光の波長程度まで集光可能を意味する。

## 【0029】

図 7 は上記実験の結果を示すグラフである。横軸はピークパワー密度であり、レーザ光がパルスレーザ光なので電界強度はピークパワー密度で表される。縦軸は 1 パルスのレーザ光により基板の内部に形成されたクラック部分(クラックスポット)の大きさを示している。クラックスポットが集まりクラック領域となる。クラックスポットの大きさは、クラックスポットの形状のうち最大の長さとなる部分の大きさである。グラフ中の黒丸で示すデータは集光用レンズ(C)の倍率が 100 倍、開口数(NA)が 0.80 の場合である。一方、グラフ中の白丸で示すデータは集光用レンズ(C)の倍率が 50 倍、開口数(NA)が 0.55 の場合である。ピークパワー密度が  $10^{11}$  ( $\text{W}/\text{cm}^2$ ) 程度から基板の内部にクラックスポットが発生し、ピークパワー密度が大きくなるに従いクラックスポットも大きくなることが分かる。

40

## 【0030】

次に、本実施形態に係るレーザ加工において、クラック領域形成による加工対象物の切断のメカニズムについて図 8～図 11 を用いて説明する。図 8 に示すように、多光子吸収が生じる条件で加工対象物 1 の内部に集光点 P を合わせてレーザ光 L を加工対象物 1 に照射

50

して切断予定ラインに沿って内部にクラック領域9を形成する。クラック領域9は1つ又は複数のクラックを含む領域である。このクラック領域9でもって切断起点領域が形成される。図9に示すように、人為的な力（例えば引張応力）を加工対象物1に印加することにより、クラック領域9を起点として（すなわち、切断起点領域を起点として）クラックがさらに成長し、図10に示すようにクラックが加工対象物1の両面に到達し、図11に示すように加工対象物1が割れることにより加工対象物1が切断される。

## 【0031】

## (2) 改質領域が溶融処理領域の場合

基板（例えばシリコンのような半導体材料）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が $1 \times 10^8$  (W/cm<sup>2</sup>) 以上で且つパルス幅が1μs以下の条件でレーザ光を照射する。これにより基板の内部は多光子吸収によって局所的に加熱される。この加熱により基板の内部に溶融処理領域が形成される。溶融処理領域とは一旦溶融後再固化した領域や、まさに溶融状態の領域や、溶融状態から再固化する状態の領域であり、相変化した領域や結晶構造が変化した領域といふこともできる。また、溶融処理領域とは単結晶構造、非晶質構造、多結晶構造において、ある構造が別の構造に変化した領域といふこともできる。つまり、例えば、単結晶構造から非晶質構造に変化した領域、単結晶構造から多結晶構造に変化した領域、単結晶構造から非晶質構造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域を意味する。基板がシリコン単結晶構造の場合、溶融処理領域は例えれば非晶質シリコン構造である。電界強度の上限値としては、例えば $1 \times 10^{12}$  (W/cm<sup>2</sup>) である。パルス幅は例えれば1ns～200nsが好ましい。

10

20

## 【0032】

本発明者は、シリコンウェハの内部で溶融処理領域が形成されることを実験により確認した。実験条件は次の通りである。

(A) 基板：シリコンウェハ（厚さ350μm、外径4インチ）

(B) レーザ

光源：半導体レーザ励起Nd：YAGレーザ

波長：1064nm

レーザ光スポット断面積： $3.14 \times 10^{-8}$  cm<sup>2</sup>

発振形態：Qスイッチパルス

繰り返し周波数：100kHz

30

パルス幅：30ns

出力：20μJ/パルス

レーザ光品質：TEM<sub>00</sub>

偏光特性：直線偏光

(C) 集光用レンズ

倍率：50倍

N.A. : 0.55

レーザ光波長に対する透過率：60パーセント

(D) 基板が載置される載置台の移動速度：100mm/秒

40

## 【0033】

図12は、上記条件でのレーザ加工により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。シリコンウェハ11の内部に溶融処理領域13が形成されている。なお、上記条件により形成された溶融処理領域13の厚さ方向の大きさは100μm程度である。

## 【0034】

溶融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを説明する。図13は、レーザ光の波長とシリコン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。ただし、シリコン基板の表面側と裏面側それぞれの反射成分を除去し、内部のみの透過率を示している。シリコン基板の厚さtが50μm、100μm、200μm、500μm、1000μmの各々について上記関係を示した。

50

## 【0035】

例えば、Nd:YAGレーザの波長である1064nmにおいて、シリコン基板の厚さが500μm以下の場合、シリコン基板の内部ではレーザ光が80%以上透過することが分かる。図12に示すシリコンウェハ11の厚さは350μmなので、多光子吸収による溶融処理領域13をシリコンウェハ11の中心付近に形成すると、シリコンウェハ11の表面から175μmの部分に形成される。この場合の透過率は、厚さ200μmのシリコンウェハを参考にすると、90%以上なので、レーザ光がシリコンウェハ11の内部で吸収されるのは僅かであり、ほとんどが透過する。このことは、シリコンウェハ11の内部でレーザ光が吸収されて、溶融処理領域13がシリコンウェハ11の内部に形成（つまりレーザ光による通常の加熱で溶融処理領域が形成）されたものではなく、溶融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを意味する。

10

## 【0036】

なお、シリコンウェハは、溶融処理領域でもって形成される切断起点領域を起点として断面方向に向かって割れを発生し、その割れがシリコンウェハの両面に到達することにより、結果的に切断される。発明者らの考察によれば、溶融処理領域を起点とした亀裂が生じるのは、溶融処理領域とそれ以外の領域との物性的な違いによってシリコンウェハの内部に歪みが生じ易くなる為だと考えられる。また、図12に示された写真からも判るように、溶融処理領域13の上下には尖頭状の溶融痕が存在する。この溶融痕によって、溶融処理領域を起点とした亀裂が精度良くシリコンウェハの両面に到達するものと考えられる。また、溶融処理領域はシリコンウェハの内部のみに形成され、切断後の切断面には、図12のように内部にのみ溶融処理領域が形成されている。基板の内部に溶融処理領域でもって切断起点領域を形成すると、切断時、切断起点領域ラインから外れた不必要な割れが生じにくいので、切断制御が容易となる。

20

## 【0037】

## (3) 改質領域が屈折率変化領域の場合

基板（例えばガラス）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が $1 \times 10^8$  (W/cm<sup>2</sup>) 以上で且つパルス幅が1ns以下の条件でレーザ光を照射する。パルス幅を極めて短くして、多光子吸収を基板の内部に起こさせると、多光子吸収によるエネルギーが熱エネルギーに転化せずに、基板の内部にはイオン価数変化、結晶化又は分極配向等の永続的な構造変化が誘起されて屈折率変化領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば $1 \times 10^{12}$  (W/cm<sup>2</sup>) である。パルス幅は例えば1ns以下が好ましく、1ps以下がさらに好ましい。

30

## 【0038】

以上、多光子吸収により形成される改質領域として(1)～(3)の場合を説明したが、加工対象物の結晶構造やその劈開性などを考慮して切断起点領域を次のように形成すれば、その切断起点領域を起点として、より一層小さな力で、しかも精度良く加工対象物を切断することが可能になる。

## 【0039】

すなわち、シリコンなどのダイヤモンド構造の単結晶半導体からなる基板の場合は、(111)面（第1劈開面）や(110)面（第2劈開面）に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。また、GaAsなどの閃亜鉛鉱型構造のIII-V族化合物半導体からなる基板の場合は、(110)面に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。さらに、サファイア(A<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)などの六方晶系の結晶構造を有する基板の場合は、(0001)面(C面)を主面として(1120)面(A面)或いは(1100)面(M面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。

40

## 【0040】

なお、基板として例えば円盤状のウェハを切断する場合、上述した切断起点領域を形成すべき方向（例えば、単結晶シリコン基板における(111)面に沿った方向）、或いは切断起点領域を形成すべき方向に直交する方向に沿ってウェハにオリエンテーションフラットを形成すれば、そのオリエンテーションフラットを基準とすることで、切断起点領域を

50

形成すべき方向に沿った切断起点領域を容易且つ正確にウェハに形成することが可能になる。

#### 【0041】

次に、上述したレーザ加工方法に使用されるレーザ加工装置について、図14を参照して説明する。図14はレーザ加工装置100の概略構成図である。

#### 【0042】

レーザ加工装置100は、レーザ光Lを発生するレーザ光源101と、レーザ光Lの出力やパルス幅等を調節するためにレーザ光源101を制御するレーザ光源制御部102と、レーザ光Lの反射機能を有しつつレーザ光Lの光軸の向きを90°変えるように配置されたダイクロイックミラー103と、ダイクロイックミラー103で反射されたレーザ光Lを集光する集光用レンズ105と、集光用レンズ105で集光されたレーザ光Lが照射される加工対象物1が載置される載置台107と、載置台107をX軸方向に移動させるためのX軸ステージ109と、載置台107をX軸方向に直交するY軸方向に移動させるためのY軸ステージ111と、載置台107をX軸及びY軸方向に直交するZ軸方向に移動させるためのZ軸ステージ113と、これら3つのステージ109, 111, 113の移動を制御するステージ制御部115とを備える。10

#### 【0043】

この集光点PのX(Y)軸方向の移動は、加工対象物1をX(Y)軸ステージ109(111)によりX(Y)軸方向に移動させることにより行う。Z軸方向は、加工対象物1の面10と直交する方向なので、加工対象物1に入射するレーザ光Lの焦点深度の方向となる。よって、Z軸ステージ113をZ軸方向に移動させることにより、加工対象物1の内部にレーザ光Lの集光点Pを合わせることができる。20

#### 【0044】

レーザ光源101はパルスレーザ光を発生するNd:YAGレーザである。レーザ光源101に用いることができるレーザとして、この他、Nd:YVO<sub>4</sub>レーザ、Nd:YLFレーザやチタンサファイアレーザがある。本実施形態では、加工対象物1の加工にパルスレーザ光を用いているが、多光子吸収を起こさせることができると連続波レーザ光でもよい。

#### 【0045】

レーザ加工装置100はさらに、載置台107に載置された加工対象物1を可視光線により照明するために可視光線を発生する観察用光源117と、ダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105と同じ光軸上に配置された可視光用のビームスプリッタ119とを備える。ビームスプリッタ119と集光用レンズ105との間にダイクロイックミラー103が配置されている。ビームスプリッタ119は、可視光線の約半分を反射し残りの半分を透過する機能を有しつつ可視光線の光軸の向きを90°変えるように配置されている。観察用光源117から発生した可視光線はビームスプリッタ119で約半分が反射され、この反射された可視光線がダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105を透過し、加工対象物1の切断予定ライン5等を含む面10を照明する。30

#### 【0046】

レーザ加工装置100はさらに、ビームスプリッタ119、ダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105と同じ光軸上に配置された撮像素子121及び結像レンズ123を備える。撮像素子121としては例えばCCDカメラがある。切断予定ライン5等を含む面10を照明した可視光線の反射光は、集光用レンズ105、ダイクロイックミラー103、ビームスプリッタ119を透過し、結像レンズ123で結像されて撮像素子121で撮像され、撮像データとなる。40

#### 【0047】

レーザ加工装置100はさらに、撮像素子121から出力された撮像データが入力される撮像データ処理部125と、レーザ加工装置100全体を制御する全体制御部127と、モニタ129とを備える。撮像データ処理部125は、撮像データを基にして観察用光源117で発生した可視光の焦点を加工対象物1の面10上に合わせるための焦点データを50

演算する。この焦点データを基にしてステージ制御部 115 が Z 軸ステージ 113 を移動制御することにより、可視光の焦点が加工対象物 1 の面 10 に合うようにする。よって、撮像データ処理部 125 はオートフォーカスユニットとして機能する。また、撮像データ処理部 125 は、撮像データを基にして面 10 の拡大画像等の画像データを演算する。この画像データは全体制御部 127 に送られ、全体制御部で各種処理がなされ、モニタ 129 に送られる。これにより、モニタ 129 に拡大画像等が表示される。

#### 【0048】

全体制御部 127 には、ステージ制御部 115 からのデータ、撮像データ処理部 125 からの画像データ等が入力し、これらのデータも基にしてレーザ光源制御部 102、観察用光源 117 及びステージ制御部 115 を制御することにより、レーザ加工装置 100 全体を制御する。よって、全体制御部 127 はコンピュータユニットとして機能する。10

#### 【0049】

次に、上述したレーザ加工装置 100 を用いた、本実施形態に係るレーザ加工方法について説明する。図 15 は、本実施形態に係るレーザ加工方法における加工対象物であるウェハ 1a を示す斜視図である。また、図 16 は、図 15 に示されたウェハ 1a の底面図である。また、図 17 は、図 16 に示されたウェハ 1a の V I - V I 断面及び V I I - V I I 断面を示す拡大図である。

#### 【0050】

図 15～図 17 を参照すると、ウェハ 1a は、平板状であり略円盤状を呈している。図 16 を参照すると、ウェハ 1a の裏面 21 には縦横に交差する複数の切断予定ライン 5 が設定されている。切断予定ライン 5 は、ウェハ 1a を複数のチップ状部分に切断するために想定される仮想線である。この切断予定ライン 5 は、例えばウェハ 1a の劈開面に沿って想定されるとよい。20

#### 【0051】

また、ウェハ 1a は、オリエンテーションフラット（以下「O F」という） 19 を有している。本実施形態では、O F 19 は縦横に交差する切断予定ライン 5 のうちの一方向と平行な方向を長手方向として形成されている。O F 19 は、ウェハ 1a を切断予定ライン 5 に沿って切断する際に、切断方向を容易に判別する目的で設けられている。

#### 【0052】

また、図 17 を参照すると、ウェハ 1a は、半導体（Si）からなる基板 15 と、基板 15 の表面 6 上に積層された積層部 4 を備えている。積層部 4 は、絶縁性材料（SiO<sub>2</sub>）からなる層間絶縁層 17a 及び 17b、並びに金属（W）からなる第 1 の配線層 19a 及び第 2 の配線層 19b を有している。層間絶縁層 17a は基板 15 の表面 6 上に積層されており、表面 6 上に複数互いに分割されて設定された素子形成領域上に第 1 の配線層 19a が積層されている。第 1 の配線層 19a 及び基板 15 は、層間絶縁層 17a を貫通するように設けられたプラグ 20a によって互いに電気的に接続されている。層間絶縁層 17b は層間絶縁層 17a 及び第 1 の配線層 19a 上に積層されており、層間絶縁層 17b 上であって第 1 の配線層 19a に対応する領域に第 2 の配線層 19b が積層されている。第 2 の配線層 19b 及び第 1 の配線層 19a は、層間絶縁層 17b を貫通するように設けられたプラグ 20b によって互いに電気的に接続されている。3040

#### 【0053】

層間絶縁層 17b 上であって第 2 の配線層 19b 同士の隙間にある領域には、切断予定ライン 5 が想定される。この切断予定ライン 5 においては、層間絶縁層 17b の表面（すなわち、ウェハ 1a の表面 3）が平坦かつ滑面となっている。

#### 【0054】

##### （第 1 の実施例）

図 18 及び図 19 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 1 実施例を説明するためのフローチャートである。また、図 20～図 22 は、本実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハ 1a の断面図である。

#### 【0055】

10

20

30

40

50

図18を参照すると、まず、ウェハ1aの表面3に積層部4を保護するための保護フィルムとして保護テープ25を装着する(S1、図20(a))。保護テープ25の材料としては、積層部4を保護する緩衝効果を有しており積層部4の動作特性に影響がなければ様々な材料を用いることができる。本実施形態では、保護テープ25の材料として、衝撃を吸収するとともに紫外線を照射することにより除去することが可能な材料を選択する。

#### 【0056】

続いて、ウェハ1aの基板15の内部に、切断予定ライン5に沿って切断起点領域8を形成する(S3、図20(b))。ここで、図20(b)に示されるウェハ1aは、表面3が図の下方になるように描かれている。すなわち、ウェハ1aの裏面21における切断予定ライン5に対応する領域をレーザ光入射面として基板15の内部の集光点Pへレーザ光Lを照射することにより、基板15の内部に改質領域として溶融処理領域13を形成する。この溶融処理領域13が、ウェハ1aを切断する際の切断起点領域8となる。

10

#### 【0057】

ここで、図19は、図14に示されたレーザ加工装置100を用いてウェハ1aに切断起点領域8を形成する方法を示すフローチャートである。なお、本実施形態において、ウェハ1aは、レーザ加工装置100の載置台107に、裏面21が集光用レンズ105と対向するように配置される。すなわち、レーザ光Lは、ウェハ1aの裏面21から入射される。

20

#### 【0058】

図14及び図19を参照すると、まず、基板15の光吸収特性を図示しない分光光度計等により測定する。この測定結果に基づいて、基板15に対して透明な波長又は吸収の少ない波長のレーザ光Lを発生するレーザ光源101を選定する(S101)。

20

#### 【0059】

続いて、基板15の厚さ、材質、及び屈折率等を考慮して、ウェハ1aのZ軸方向の移動量を決定する(S103)。これは、ウェハ1aの裏面21から所定距離内側の所望の位置にレーザ光Lの集光点Pを合わせるために、ウェハ1aの裏面21に位置するレーザ光Lの集光点Pを基準としたウェハ1aのZ軸方向の移動量である。この移動量は全体制御部127に入力される。

#### 【0060】

ウェハ1aをレーザ加工装置100の載置台107にウェハ1aの裏面21が集光用レンズ105側と対向するよう載置する。このとき、積層部4が設けられているウェハ1aの表面3には保護テープ25が装着されているので、ウェハ1aの表面3側を下にして載置台107に載置しても何ら問題ない。そして、観察用光源117から可視光を発生させてウェハ1aの裏面21を照明する(S105)。照明されたウェハ1aの裏面21を撮像素子121により撮像する。撮像素子121により撮像された撮像データは撮像データ処理部125に送られる。この撮像データに基づいて撮像データ処理部125は、観察用光源117の可視光の焦点がウェハ1aの裏面21に位置するような焦点データを演算する(S107)。

30

#### 【0061】

この焦点データはステージ制御部115に送られる。ステージ制御部115は、この焦点データを基にしてZ軸ステージ113をZ軸方向の移動させる(S109)。これにより、観察用光源117の可視光の焦点がウェハ1aの裏面21に位置する。なお、撮像データ処理部125は撮像データに基づいて、切断予定ライン5を含む裏面21の拡大画像データを演算する。この拡大画像データは全体制御部127を介してモニタ129に送られ、これによりモニタ129に切断予定ライン5付近の拡大画像が表示される。

40

#### 【0062】

全体制御部127には予めステップS103で決定された移動量データが入力されており、この移動量データがステージ制御部115に送られる。ステージ制御部115はこの移動量データに基づいて、レーザ光Lの集光点Pの位置がウェハ1aの裏面21から所定距離内側となるように、Z軸ステージ113によりウェハ1aをZ軸方向に移動させる(S

50

111)。

【0063】

続いて、レーザ光源101からレーザ光Lを発生させて、レーザ光Lをウェハ1aの裏面21に照射する。レーザ光Lの集光点Pは基板15の内部に位置しているので、改質領域である溶融処理領域13は基板15の内部にのみ形成される。そして、切断予定ライン5に沿うようにX軸ステージ109やY軸ステージ111を移動させて溶融処理領域13を複数形成するか、あるいは切断予定ライン5に沿って連続して溶融処理領域13を形成することにより、切断予定ライン5に沿う切断起点領域8を基板15の内部に形成する(S113)。

【0064】

再び図18を参照すると、ウェハ1aの裏面21に伸張性のフィルムであるエキスバンドテープ23を装着する(S5、図20(c))。エキスバンドテープ23は、例えば伸張方向に力を加えることによって伸びる材料からなり、後の工程において、ウェハ1aをチップ状に分離させるために用いられる。エキスバンドテープ23としては、伸張方向に力を加えることによって伸びるもの以外にも例えば加熱により伸びるものでもよい。

【0065】

続いて、切断起点領域8に沿ってウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断する(S7、図21(a))。すなわち、ウェハ1aの裏面21に装着されたエキスバンドテープ23の上から切断起点領域8にあわせてナイフエッジ33を当て、ウェハ1aに曲げ応力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1aを割断(ブレーキング)する。このとき、ウェハ1a内部には切断起点領域8から表面3及び裏面21へ達する亀裂18が生じ、基板15が切断されると同時に、層間絶縁層17a及び17bも切断される。ウェハ1aに応力を印加する手段としては、ナイフエッジ33以外にも例えばブレーキング装置、ローラー装置などがある。また、ウェハ1aの表面3や裏面21にその面が溶融しないエネルギーにてウェハ1aに対して吸収性を有するレーザ光を照射することで切断起点領域8を起点として亀裂が生じるような熱応力を発生させて切断してもよい。また、ウェハ1aの表面3に装着された保護テープ25の上からナイフエッジ33等を当てて曲げ応力を印加してもよい。

【0066】

続いて、ウェハ1aの表面3に装着された保護テープ25に紫外線Vを照射する(S9、図21(b))。保護テープ25に紫外線Vを照射することによって、保護テープ25を除去可能な状態とする。そして、保護テープ25をウェハ1aの表面3から剥離する(S11、図21(c))。なお、保護テープ25の剥離はウェハ1aを切断する工程(S7)の前に行っても良い。

【0067】

続いて、ウェハ1aを個々のチップ状部分24に分離する(S13、図22)すなわち、エキスバンドテープ23を伸張させることにより複数のチップ状部分24の間に間隔26をあける。こうすることにより、複数のチップ状部分24のそれぞれをピックアップし易くなる。

【0068】

以上説明したように、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの表面3に保護テープ25を装着することによって、ウェハ1aを裏面21を上にして載置台107上に載置することができるので、ウェハ1aの裏面21から基板15の内部にレーザ光Lを好適に照射することができる。

【0069】

そして、多光子吸収という現象により形成される改質領域でもって、ウェハ1aを切断すべき所望の切断予定ライン5に沿った切断起点領域8を基板15の内部に形成し、この切断起点領域8を起点としてウェハ1aを切断することができる。そして、ウェハ1aの裏面21にエキスバンドテープ23を装着してこれを伸張させることにより、切断されたウェハ1aの複数のチップ状部分24を容易に分離することができる。

10

20

30

40

50

## 【0070】

すなわち、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、ウェハ1aの表面3にある積層部4にレーザ光Lを直接照射せずに切断起点領域8を形成できるので、レーザ光Lによる積層部4の損傷を防止することができる。また、基板15内部に切断起点領域8を形成することにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断されたウェハ1aを容易に分離することができる。従って、このレーザ加工方法によれば、ウェハ1aが積層部4を有する場合においてもウェハ1aを高精度に切断することができる。

## 【0071】

また、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、従来のブレードダイシング法などと比べてチップ状部分24の間のダイシング幅を格段に小さくすることができる。そして、そのようにダイシング幅を小さくした場合、個々のチップ状部分24同士の間隔を小さくし、より多くのチップ状部分24を取り出すことが可能になる。10

## 【0072】

また、積層部4の構成材料やレーザ光Lの照射条件などによっては、積層部4の素子形成領域にレーザ光Lが照射されないように考慮する必要が生じる場合がある。特に本方法では多光子吸収現象を利用するためにレーザ光Lを急激に絞り込んでいるので、積層部4の素子形成領域にレーザ光Lが照射されないようにしつつ表面3からレーザ光Lを照射することが困難な場合がある。また、一般的に、ウェハの素子形成領域間には素子用に積層された半導体層が存在することが多い。或いは、メモリや集積回路素子などにおいては素子形成領域間にTEG (Test Element Group) 等の機能素子が形成されている場合もある。これらのような場合に、本実施例に係るレーザ加工方法を用いれば、積層部4が設けられていない裏面21からレーザ光Lを照射して基板15の内部に切断起点領域8を好適に形成することができる。20

## 【0073】

また、本実施例に係るレーザ加工方法では、ウェハ1aにナイフエッジ33等による外力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断している。これによって、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを容易に切断することができる。

## 【0074】

また、本実施例に係るレーザ加工方法では、エキスパンドテープ23をウェハ1aに装着した後に、保護テープ25を除去している。これによって、切断起点領域8が形成されたウェハ1aを個々のチップ状部分24に離散させることなく保持することができる。30

## 【0075】

図23は、本実施例に係るレーザ加工方法の変形例を説明するための断面図である。本変形例では、基板15の内部において、基板15の厚さ方向に複数の溶融処理領域13を形成する。溶融処理領域13をこのように形成するには、図19に示されたフローチャートのステップS111（ウェハをZ軸方向に移動）とステップS113（改質領域の形成）とを交互に複数回行うとよい。また、ウェハ1aをZ軸方向に移動するのと改質領域の形成とを同時に行うことにより、基板15の厚さ方向に連続して溶融処理領域13を形成してもよい。40

## 【0076】

本変形例のように溶融処理領域13を形成することにより、基板15の厚さ方向に延びた切断起点領域8を形成することができる。従って、ウェハ1aをより小さな力で割って切断することができる。さらに、基板15の厚さ方向に溶融処理領域13による亀裂を成長させれば、外部からの力を必要とせずウェハ1aを分離することもできる。

## 【0077】

## (第2の実施例)

図24は、本実施形態によるレーザ加工方法の第2実施例を示すフローチャートである。また、図25～図27は、本実施例を説明するためのウェハ1aの断面図である。本実施50

例と上述した第1実施例との相違点は、(1)基板15が薄くなるように研削する点、(2)ナイフエッジ33等を用いたブレーキングを行わない点、(3)ウェハ1aを複数のチップ状部分24に分離した後に保護テープ25を剥離する点、の3点である。

#### 【0078】

図24を参照すると、まず、ウェハ1aの表面3に保護テープ25を装着する(S21、図25(a))。この工程は、第1実施例におけるステップS1と同様なので、詳細な説明を省略する。

#### 【0079】

続いて、ウェハ1aの裏面21を研削する(S23、図25(b))。このとき、基板15の厚さを例えば30μm～50μmまで薄くなるように研削(グラインド)する。また、次の工程においてレーザ光Lを裏面21から好適に入射させるために、研削後の裏面21が平坦かつ滑面となるように裏面21を研削するとよい。

10

#### 【0080】

続いて、ウェハ1aの基板15の内部に、切断予定ライン5に沿って切断起点領域8を形成する(S25、図25(c))。続いて、ウェハ1aの研削後の裏面21に、エキスバンドテープ23を装着する(S27、図26(a))。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS3及びS5と同様なので、詳細な説明を省略する。

10

#### 【0081】

続いて、エキスバンドテープ23を伸張させることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するとともに、個々のチップ状部分24を互いに分離させる(S29、図26(b))。このとき、前述したステップS23において基板15が充分に薄くなるように研削したので、エキスバンドテープ23を伸張させることによる引張応力のみによって、切断起点領域8を起点としてウェハ1aが切断される。そして、エキスバンドテープ23をそのまま伸張させることにより複数のチップ状部分24の間に間隔26をあける。

20

#### 【0082】

続いて、保護テープ25に紫外線を照射し(S31、図26(c))、保護テープ25をウェハ1aの表面3から剥離する(S33、図27)。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS9及びS11と同様なので、詳細な説明を省略する。なお、保護テープ25の剥離はエキスバンドテープ23を伸張させウェハ1aを切断する工程(S29)の前に行っても良い。

30

#### 【0083】

本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第1実施例と同様に、ウェハ1aの表面3にある積層部4にレーザ光Lを直接照射せずに切断起点領域8を形成できるので、レーザ光Lによる積層部4の損傷を防止することができる。また、基板15内部に切断起点領域8を形成することにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断されたウェハ1aを容易に分離することができる。従つて、このレーザ加工方法によれば、ウェハ1aが積層部4を有する場合においてもウェハ1aを高精度に切断することができる。

30

#### 【0084】

また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの基板15が薄くなるようにウェハ1aの裏面21を研削している。これによって、切断起点領域8を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせずにウェハ1aを切断することができる。また、基板15が比較的厚い場合に比べてより精度良くウェハ1aを切断することができる。

40

#### 【0085】

また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの裏面21に装着したエキスバンドテープ23を伸張させることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するとともに複数のチップ状部分24を互いに分離している。エキスバンドテープ23を伸張させる際には、ウェハ1aの切断起点領域8に引張応力が印加されるので、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを好適に切断することができる。

50

きる。従って、本実施形態によれば、ウェハ 1 a を切断する工程と、複数のチップ状部分 2 4 を互いに分離する工程とを同時に行うことができるので、製造工程を削減することができる。

#### 【0086】

また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ 1 a の裏面 2 1 をレーザ光入射面としてレーザ光 L を照射している。発明者らの実験によれば、溶融処理領域 1 3 などの改質領域は、基板 1 5 内部のうちレーザ光入射面側に偏って形成される傾向がある。従って、本レーザ加工方法では、エキスパンドテープ 2 5 が装着される裏面 2 1 側に偏って切断起点領域 1 3 が形成される傾向がある。一方、エキスパンドテープ 2 3 を伸張させると、基板 1 5 の裏面 2 1 付近のほうが表面 6 付近に比べてより大きな引張応力を印加される。従って、基板 1 5 内部において切断起点領域 8 が裏面 2 1 側に偏っていれば、エキスパンドテープ 2 5 を伸張させることによる引張応力をより効果的に切断起点領域 8 に作用させることができる。以上のことから、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、切断起点領域 8 に引張応力をより効果的に作用させ、より小さな力でウェハ 1 a を切断することができる。

10

#### 【0087】

また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、エキスパンドテープ 2 3 を伸張させることによりウェハ 1 a の複数のチップ状部分 2 4 を分離した後に、保護テープ 2 5 を除去している。これによって、ウェハ 1 a を切断してから複数のチップ状部分 2 4 を取り出すまでの間、該複数のチップ状部分 2 4 を保護することができる。

20

#### 【0088】

##### (第3の実施例)

図 2 8 は、本実施形態によるレーザ加工方法の第3実施例を示すフローチャートである。本実施例と上述した第1実施例との相違点は、(1)ナイフェッジ 3 3 等を用いたブレーキングを行わない点、の1点である。本変形例では、第1実施例にて示した図 2 0 ~ 図 2 2 を参照しながら説明する。

20

#### 【0089】

図 2 8 を参照すると、まず、ウェハ 1 a の表面 3 に保護テープ 2 5 を装着する(S 4 1、図 2 0 (a))。続いて、ウェハ 1 a の基板 1 5 の内部に、切断予定ライン 5 に沿って切断起点領域 8 を形成する(S 4 3、図 2 0 (b))。続いて、ウェハ 1 a の裏面 2 1 に、エキスパンドテープ 2 3 を装着する(S 4 5、図 2 0 (c))。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップ S 1 ~ S 5 と同様なので、詳細な説明を省略する。

30

#### 【0090】

続いて、保護テープ 2 5 に紫外線を照射し(S 4 7、図 2 1 (b))、保護テープ 2 5 をウェハ 1 a の表面 3 から剥離する(S 4 9、図 2 1 (c))。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップ S 9 及び S 1 1 と同様なので、詳細な説明を省略する。ただし、本変形例ではナイフェッジ 3 3 による応力の印加を行ないので、図 2 1 (b) 及び (c) に示されている亀裂 1 8 は生じない。

40

#### 【0091】

続いて、エキスパンドテープ 2 3 を伸張させることにより、切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1 a を複数のチップ状部分 2 4 に切断するとともに、個々のチップ状部分 2 4 を互いに分離させる(S 5 1、図 2 2)。このとき、本実施例では前述した第2実施例のように基板 1 5 を薄く研削していないので、エキスパンドテープ 2 3 を伸張させることによる引張応力を第2実施例よりも大きくすることにより、切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1 a が切断される。そして、エキスパンドテープ 2 3 をそのまま伸張させることにより複数のチップ状部分 2 4 の間に間隔 2 6 をあける。

#### 【0092】

本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第1実施例と同様の理由により、ウェハ 1 a が積層部 4 を有する場合においてもウェハ 1 a を高精度に切断することができる

50